

a 2014 0071

Invenția se referă la tehnica semiconductorilor oxizi, în particular la senzori de gaze pe bază de oxid de molibden. Senzorul de gaze pe bază de MoO_3 include un substrat dielectric, pe una din suprafețele căruia este amplasat un strat senzitiv din MoO_3 , cu contacte ohmice depuse pe acesta, formând zona senzitivă, iar pe suprafața opusă a substratului este depus un element de încălzire. Stratul senzitiv este executat în formă de o bandă nanocristalină cu grosimea de 150 nm și lățimea zonei senzitive de 150 μm .

Revendicări: 1

Figuri: 4